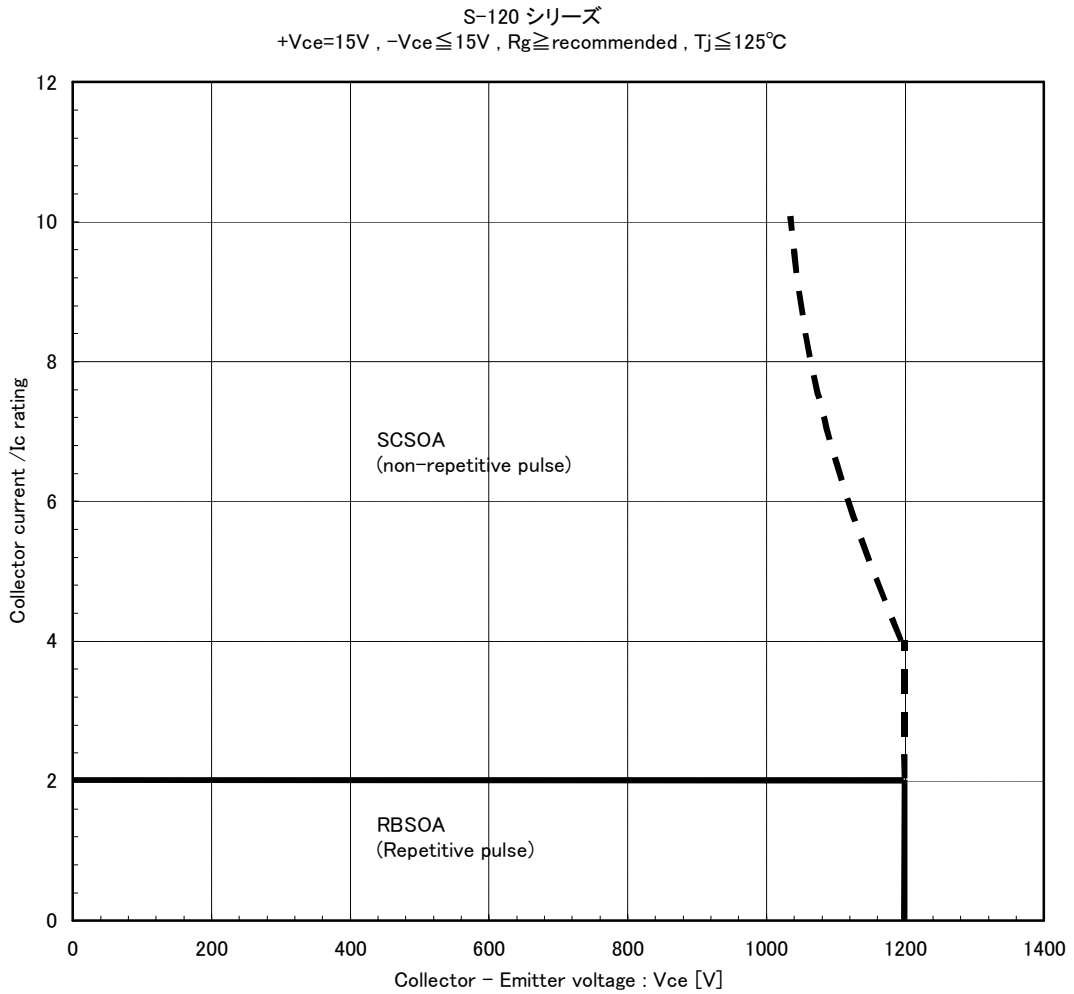

富士 IGBT モジュール S-120 シリーズ

技術資料

1.	RBSOA, SCSOA	MT5F10398
2.	大電流出力特性	MT5F19810
3.	耐圧と接合部温度の依存性	MT5F20007
4.	di_c/dt と T_j 特性	MT5F19889
5.	ダイナミックアバランシエ電圧と T_j 特性	MT5F19892

富士 IGBT モジュール S-120 シリーズ
RBSOA, SCSOA

測定素子: 2MBI150SC-120



技術資料 | MT5F15412

2008-03-27

富士 IGBT モジュール S-120 シリーズ
大電流出力特性

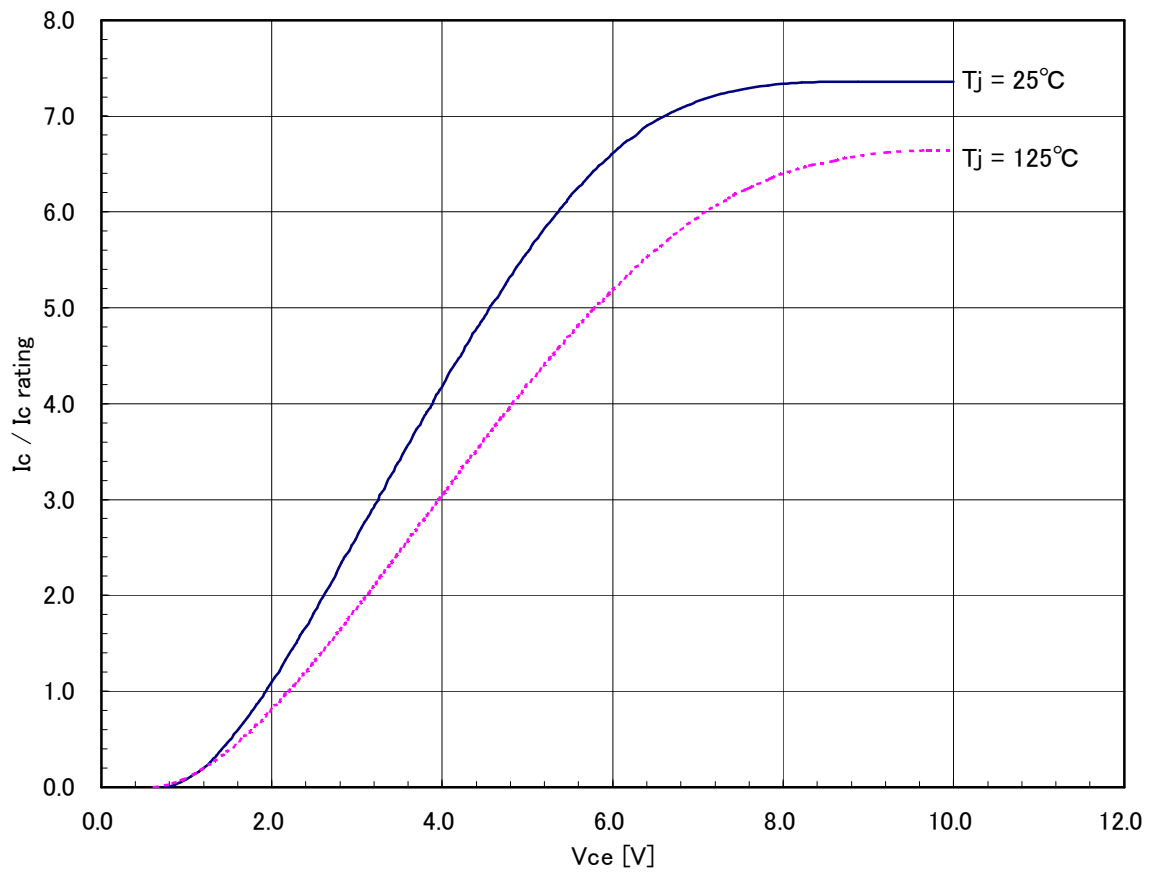
S-120 シリーズ

条件: $T_j=25/125^{\circ}\text{C}$

$V_{GE}=15\text{V}$

注: 数値はモジュールの内部抵抗による内部電圧低下分を含んでいます。

S - 120 シリーズ

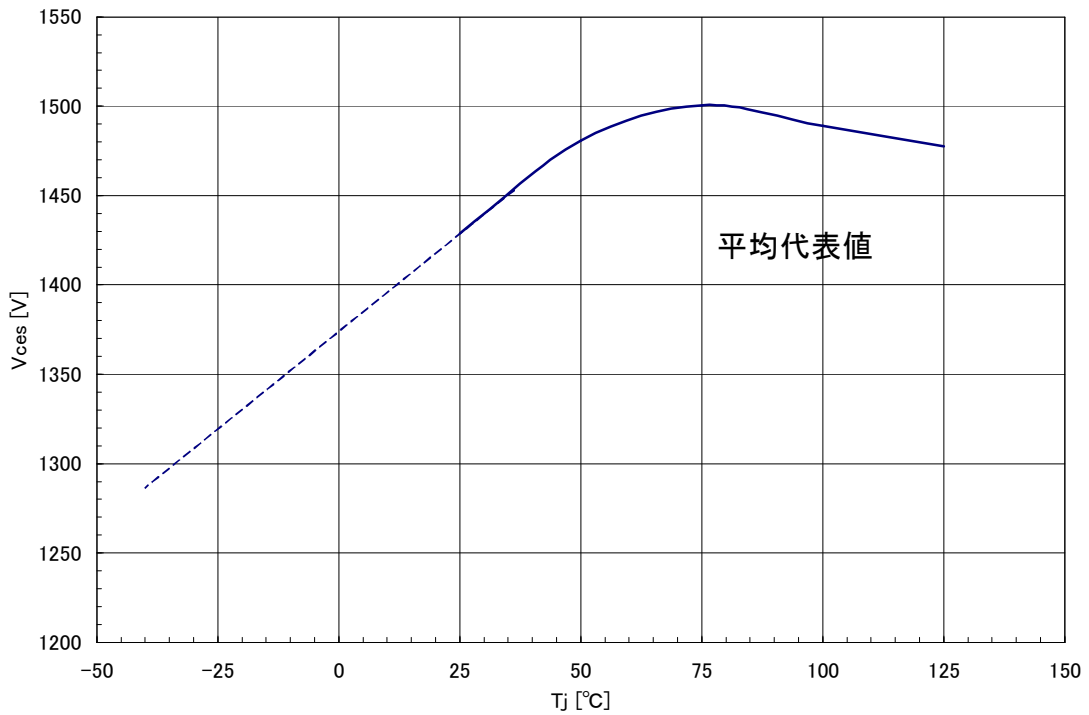


技術資料 | MT5F19810

2008-03-27

富士 IGBT モジュール S-120 シリーズ
耐圧と接合部温度の依存性

測定素子: 7MBI150SD120-50



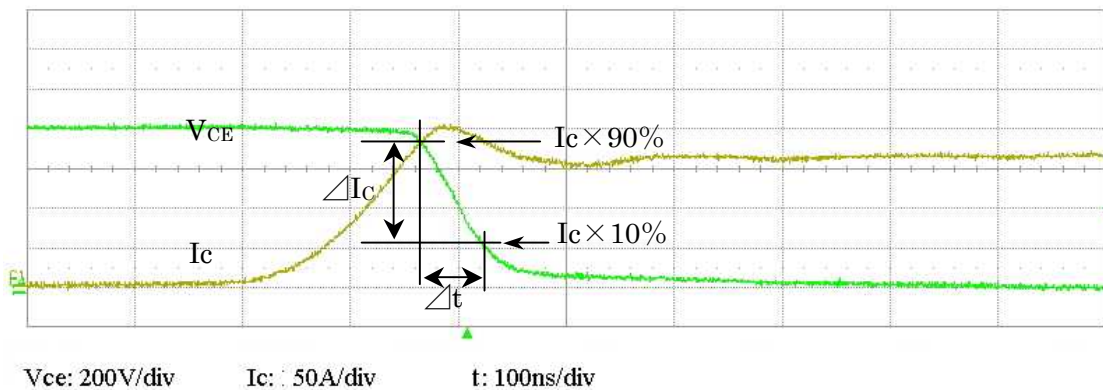
技術資料 | MT5F20007

2008-03-27

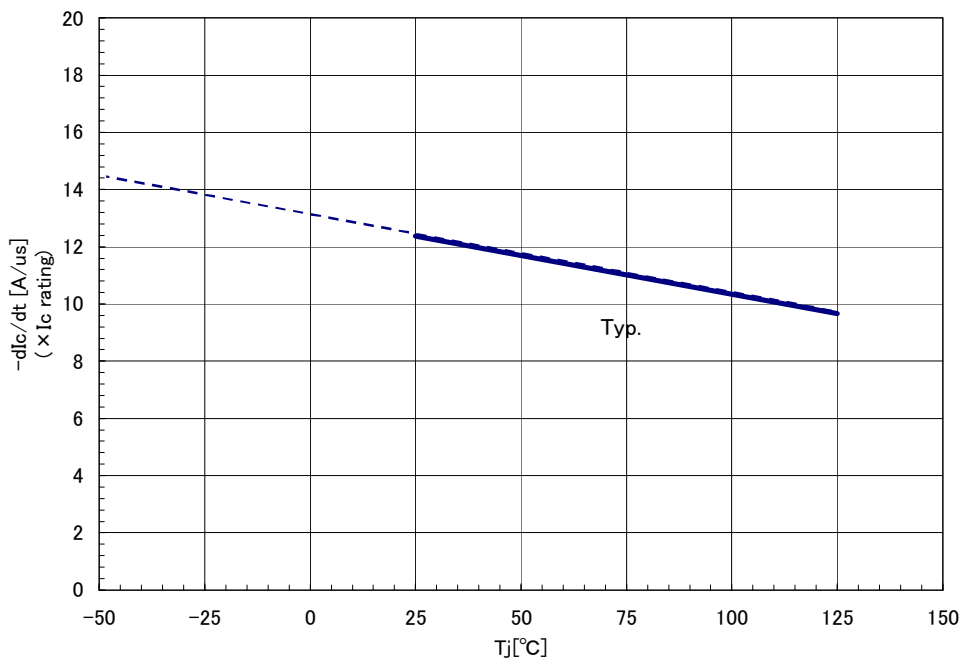
富士 IGBT モジュール S-120 シリーズ
-dIc/dt と T_j 特性

測定素子: 2MBI200S-120

測定条件: V_{DC}=600V, I_C=200A, V_{GE}=±15V, R_G=4.7Ω



S-120 シリーズ



技術資料 MT5F19889

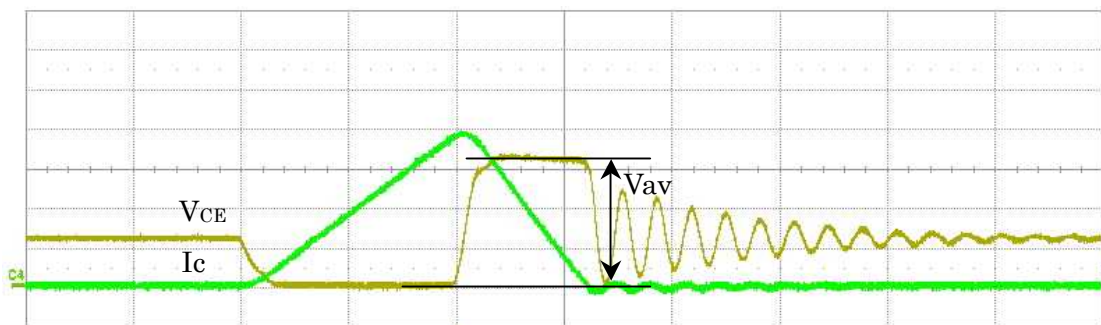
2008-03-27

富士 IGBT モジュール S-120 シリーズ
ダイナミックアバランシェ電圧と T_j 特性

測定素子: 2MBI200U2A-120

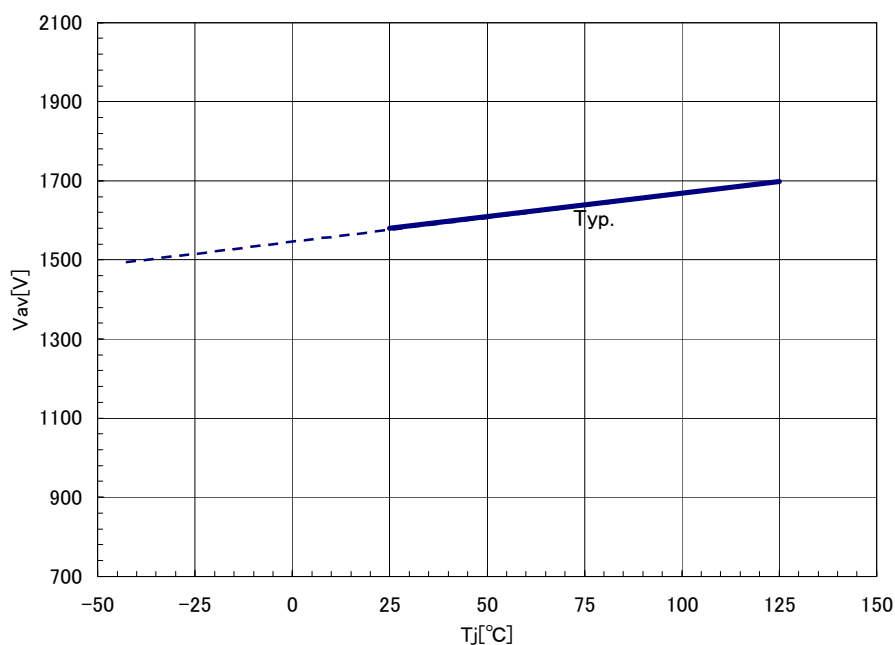
測定条件: $V_{DC}=600V$, $I_C=2 \times$ 定格値

$V_{GE}=\pm 15V$, R_G =推奨値



Vce: 500V/div Ic: 100A/div t: 100 μ s/div

2MBI200S-120



技術資料 | MT5F19892

2008-03-27